

平成 28 年度 TIA 連携プログラム探索推進事業「かけはし」

「ダイヤモンド電子デバイス実用化のための調査研究」

第三回ワークショップ



「新しい知の創造と産業界への橋渡し」を目指し、かけはし（TIA 連携プログラム探索推進事業）のテーマの一つとして、ダイヤモンド電子デバイスの実用化を目指した、調査研究を進めております。

<https://www.tia-nano.jp/kakehashi/index.html>

<https://www.tia-nano.jp/kakehashi/info/TK16-3.pdf>

TIA 五機関を中心に、国内ダイヤモンド研究者の協力体制の構築が主な目的ですが、広く多くの皆様へもお声掛けをし、ダイヤモンド電子デバイス実用化のために必要な研究テーマの明確化、ダイヤモンド研究の拡大を図りたいと考えております。

皆様のご参加をお待ちしております。

3月29日 午後1時30分より17時まで

会場 東京大学 本郷キャンパス 工学部2号館3階 電気系会議室 1A-1C

13:30-13:40 産業技術総合研究 山崎聡

開催の目的について

13:40-14:25 早稲田大学 川原田洋

相補型インバーターのための二次元正孔ガス層を利用したダイヤモンド高耐圧 p チャンネル電界効果トランジスタ

14:25-15:10 産業技術総合研究所 原史朗

ハーフィンチウエハを用いる超小型デバイス製造システム・ミニマルファブ、その開発と応用

15:10-15:30 休憩

15:30-16:15 物質・材料研究機構 寺地徳之

超高純度ダイヤモンド気相成長

16:15-17:00 産業技術総合研究所 加藤宙光

不純物ドーピングによるダイヤモンド半導体の伝導制御技術とそのデバイス応用

参加ご希望の方は、

産業技術総合研究所

先進パワーエレクトロニクス研究センター

ダイヤモンドデバイスチーム

三上舞子 mikami-maiko@aist.go.jp

まで、ご連絡ください。